

RH

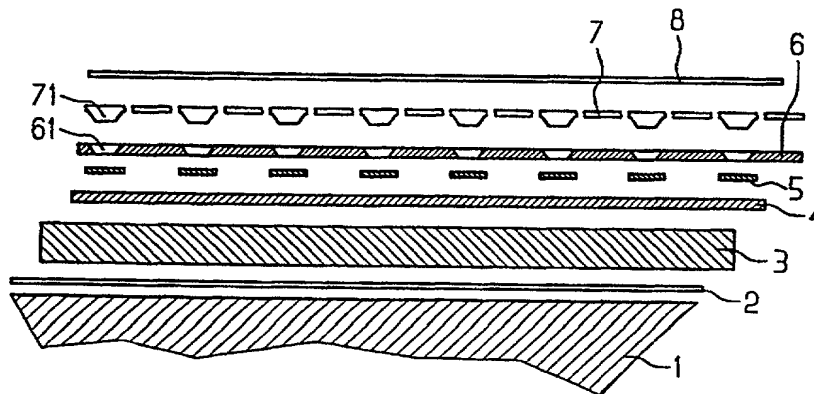
**PCT**  
WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM  
Internationales Büro  
INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE  
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)



(51) Internationale Patentklassifikation <sup>7</sup> : <b>G06K 9/00</b>	A3	(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: <b>WO 00/13129</b> (43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 9. März 2000 (09.03.00)
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE99/02631 (22) Internationales Anmeldedatum: 24. August 1999 (24.08.99) (30) Prioritätsdaten: 198 39 642.2 31. August 1998 (31.08.98) DE (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE). (72) Erfinder; und (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): ZELLNER, Max [DE/DE]; Bürgermeister-Haller-Strasse 3a, D-85244 Röhmoos (DE). ZAPF, Jörg [DE/DE]; Dalandstrasse 1, D-81927 München (DE). DEMMER, Peter [DE/DE]; Bertelestrasse 24, D-81479 München (DE). (74) Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS AKTIENGE- SELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, D-80506 München (DE).		(81) Bestimmungsstaaten: JP, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).  Veröffentlicht <i>Mit internationalem Recherchenbericht.</i>  (88) Veröffentlichungsdatum des internationalen Recherchen- berichts: 22. Juni 2000 (22.06.00)

(54) Title: METHOD FOR PRODUCING METALLIC MICROSTRUCTURES AND USE OF THIS METHOD IN THE PRODUCTION OF SENSOR DEVICES FOR DETECTING FINGERPRINTS

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG METALLISCHER FEINSTRUKTUREN UND ANWENDUNG DES VERFAHRENS BEI DER HERSTELLUNG VON SENSORANORDNUNGEN ZUR ERFASSUNG VON FINGER-ABDRÜCKEN



(57) Abstract

A thin base layer (3) consisting of a flexible material is applied to a rigid auxiliary support (1) and metallic microstructures (5), especially printed conductors, are then produced on said base layer (3). The base layer (3) is subsequently removed from the auxiliary support (1) using laser radiation which is directed through the auxiliary support (1) and onto the base layer (3).

(57) Zusammenfassung

Auf einem starren Hilfsträger (1) wird eine dünne Basisschicht (3) aus einem flexiblen Material aufgebracht, worauf auf der Basisschicht (3) metallische Feinstrukturen (5), insbesondere Leiterbahnstrukturen, erzeugt werden. Anschließend wird die Basisschicht (3) vom Hilfsträger (1) durch Einwirkung von Laserstrahlung abgelöst, die durch den Hilfsträger (1) hindurch auf die Basisschicht (1) gerichtet wird.